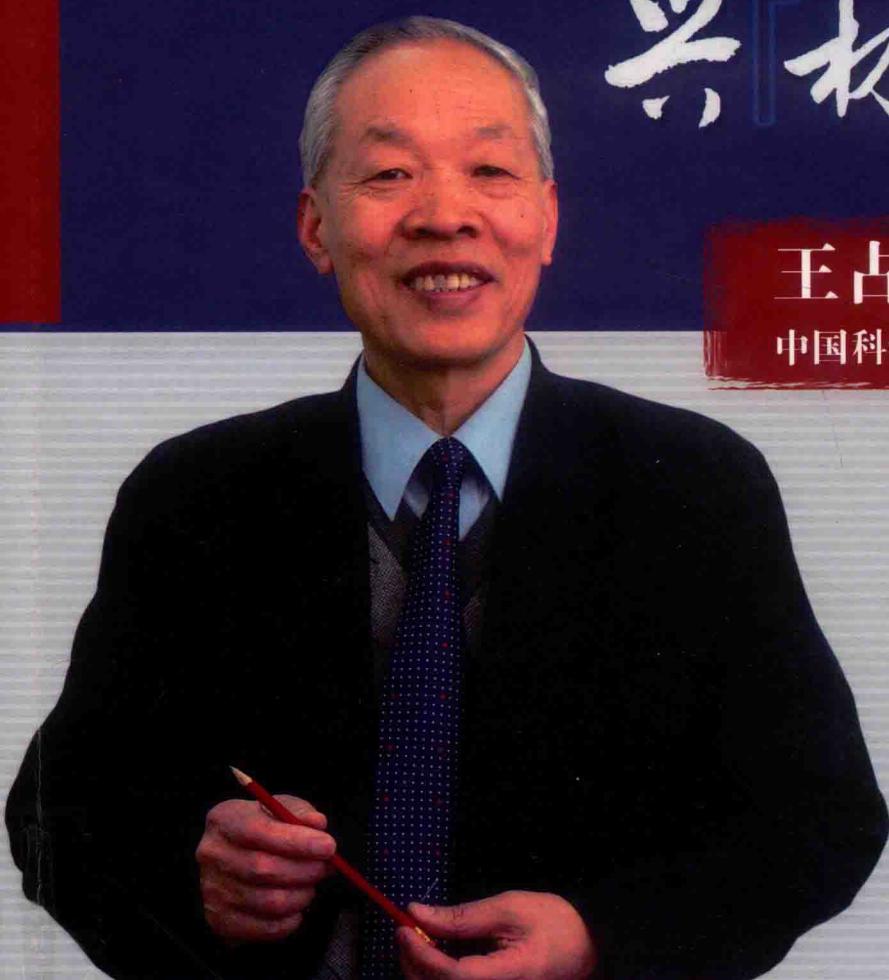


占「薪」為民
興「材」報國

王占国院士文集

中国科学院半导体研究所 编



科学出版社

占『新』為民
興『材』報國

王占国院士文集

中国科学院半导体研究所 编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书梳理和总结了中国科学院院士、半导体材料及材料物理学家王占国院士近 60 年从事半导体材料领域科研活动的历程。主要包括王占国院士生活和工作的珍贵照片、有代表性的研究论文、科研和工作事迹、回忆文章、获授奖项以及育人情况等内容。王占国院士是我国著名的半导体材料及材料物理学家，对推动我国半导体材料科学领域的学术繁荣、学科发展、技术创新、产业振兴以及人才培养做出了重要贡献。

本书可供从事半导体材料等相关专业的科研人员和管理工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

占“新”为民 兴“材”报国：王占国院士文集 / 中国科学院半导体研究所编. —北京：科学出版社，2018.11

ISBN 978-7-03-059106-7

I. ①占… II. ①中… III. ①半导体材料—物理性能—文集
IV. ①TN304.01—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 238064 号

责任编辑：李 敏 / 责任校对：彭 涛

责任印制：肖 兴 / 封面设计：王 浩

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 11 月第 一 版 开本：787×1092 1/16

2018 年 11 月第一次印刷 印张：40 1/4 插页：24

字数：1 380 000

定价：480.00 元

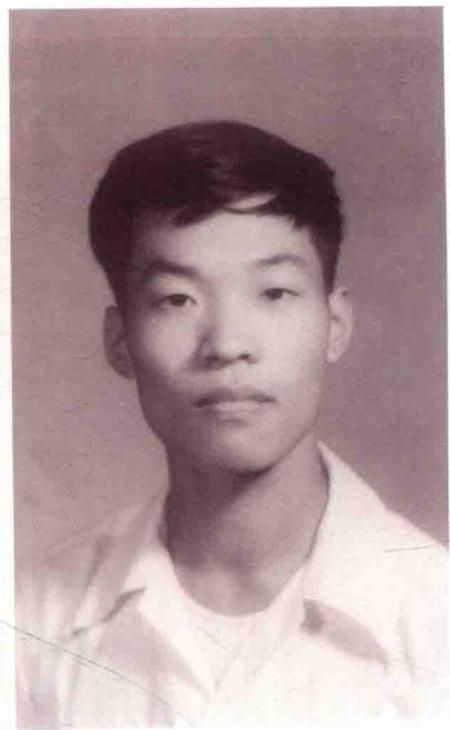
(如有印装质量问题，我社负责调换)



王占国院士



1959年，南开大学物理系57级篮球队合影（前排右二）



1960年，于南开大学



1961年，南开大学物理系57级部分同学在主楼前合影
(后排左二)



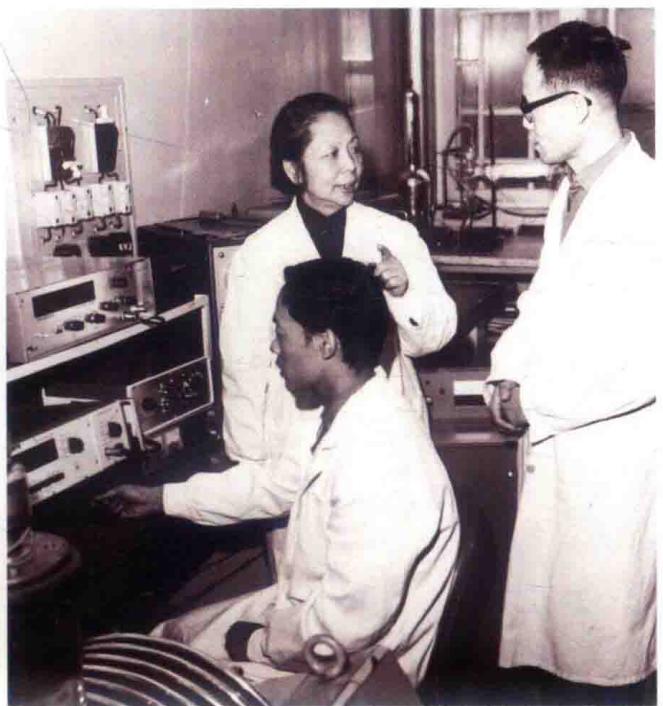
1968年夏，于武汉



1965年，在半导体研究所民兵登香山鬼见愁活动中获得第一名（前排右一）



1973年，与母亲张秉芝在天安门前



1978年，与林兰英（后）和徐寿定（右）在实验室



1980年10月，出国进修前于北京全家合影



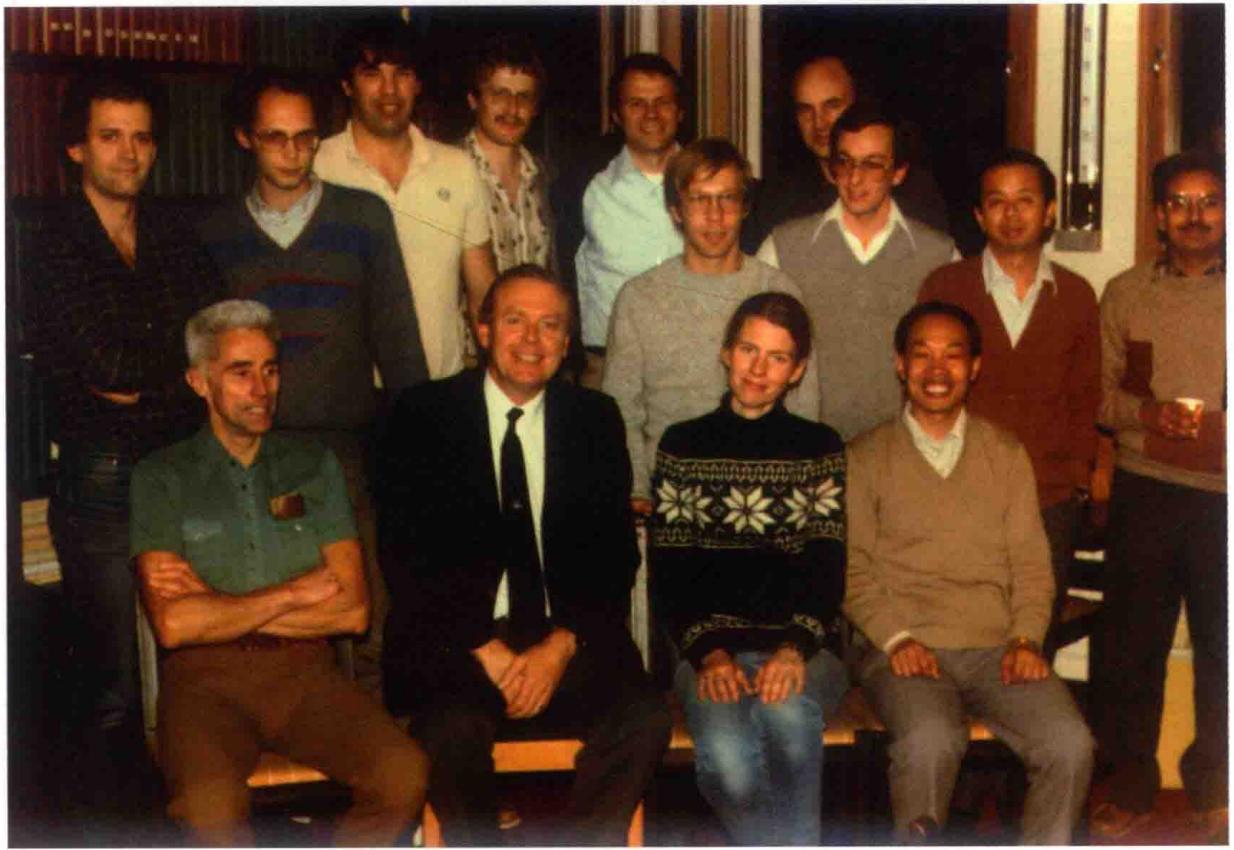
1982年9月，在法国参加国际半导体物理会议时与Bo Monemar（右二）和H. P. Gislason（中）等合影



1981年，在瑞典隆德大学固体物理系实验室工作



1982年9月，在意大利Cagliari参加三元-四元化合物半导体材料国际会议



1983年11月，结束进修回国前与Grimmeiss教授（前排左二）等合影



1984年1月，于丹麦哥本哈根



1984年，与父亲王克佑在半导体研究所宿舍



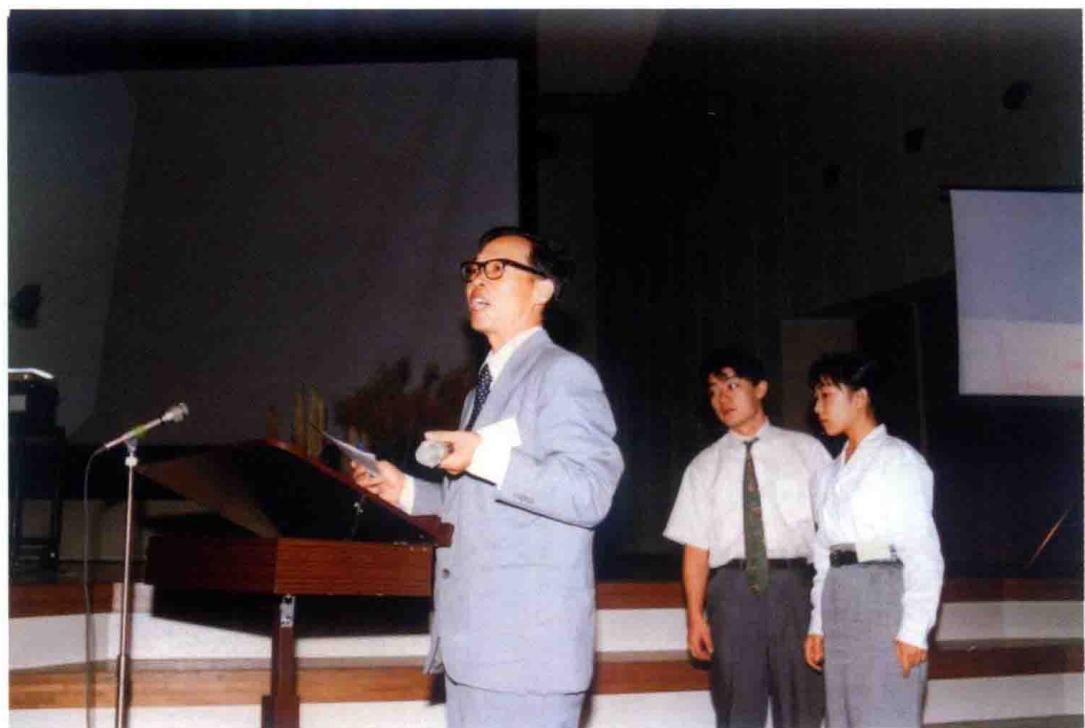
1986年10月，在广州黄埔军校前与黄昆教授（前排左四）等合影



1988年7月，与褚一鸣（左一）、林兰英（右二）和范提文（右一）在半导体研究所合影



1988年10月，与林兰英（左后）和Pankov（右）在美国科罗拉多州



1989年9月，在日本东京DRIP-3国际会议上作大会邀请报告



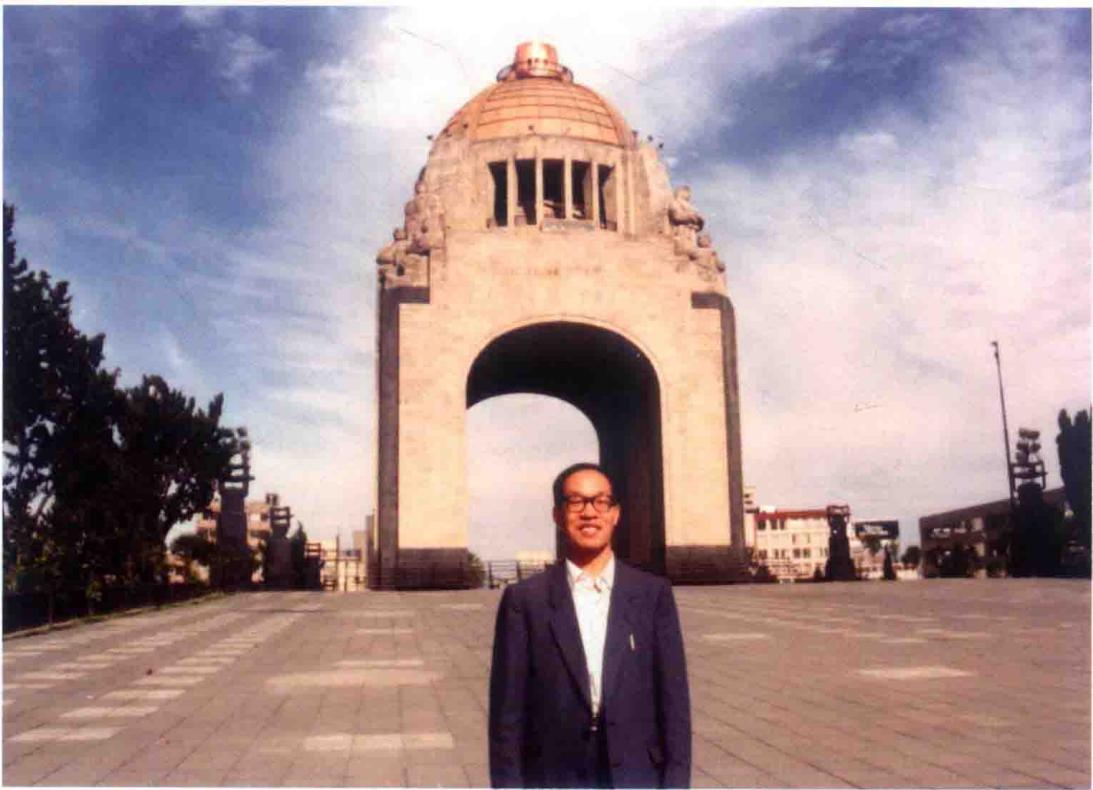
1990年，与保加利亚籍博士研究生库意沃在半导体研究所实验室



1991年5月，参加在匈牙利布达佩斯举行的欧洲第三届晶体生长会议



1991年11月，与郑有炓（左一）、小川智哉（右三）、麦振洪（右一）等
在美国夏威夷



1992年2月，于印度新德里



1992年10月，南开大学57级毕业30周年于母校行政楼前合影（第四排左一）



1992年10月，于俄罗斯莫斯科红场



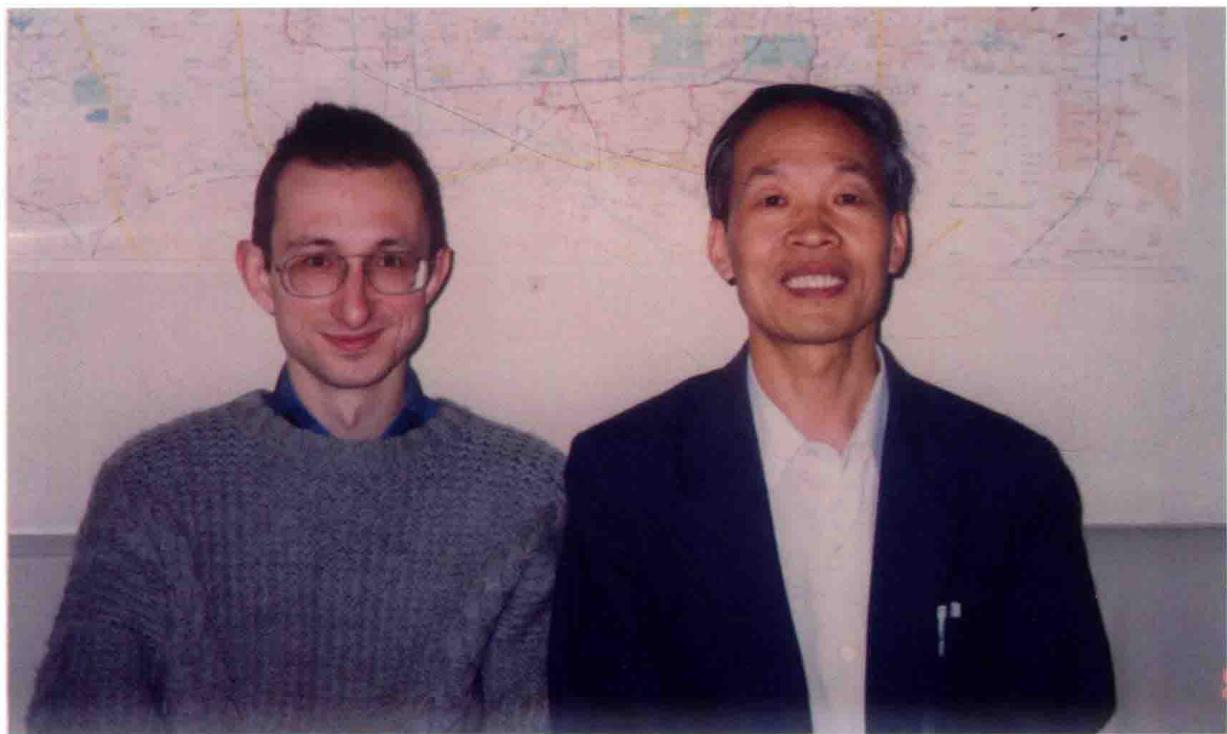
1993年，与刘巽琅（左一）、林兰英（右二）和郁元桓（右一）在慕田峪长城



1994年2月，同蒋民华（左一）访问美国佛罗里达大学与材料系教授以及半导体研究所访问学者周伯骏（右一）等合影



1994年6月11日，于冰岛死火山口边



1994年9月，与俄罗斯籍博士后V. L. Dostov在半导体研究所



1994年10月，与熊家炯（左）和蒋民华（中）在俄罗斯圣彼得堡夏宫



1995年7月17日，与Sasaki教授（中）和蒋民华（左）在日本大阪